

(19) KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020040079476 A
 (43) Date of publication of application: 16.09.2004

(21) Application number: 1020030014283

(22) Date of filing: 07.03.2003

(71) Applicant:

LG. PHILIPS LCD CO., LTD.

(72) Inventor:

PARK, JAE YONG

(51) Int. Cl

H05B 33/22

(54) ORGANIC ELECTRO-LUMINESCENCE DEVICE WITH TFT ARRAY AND ORGANIC Emitter FORMED ON SEPARATE SUBSTRATE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: An organic electro-luminescence device and a manufacturing method thereof are provided to improve production efficiency by forming a thin film transistor array unit and an organic emitter on a separate substrate.

CONSTITUTION: A driving device(1) has an extension unit extended to a pixel area. A protecting film includes a first contact hole which exposes a drain electrode(128) of the driving device and a second contact hole which exposes an extension unit of the drain electrode. A gap maintenance unit(140) is formed on the exposed extension unit. A connection electrode(142) is connected to the exposed drain electrode of the driving device and formed along the gap maintenance unit, thereby being contacted to the exposed extension unit around the gap maintenance unit. A first transparent electrode(202) is provided on a surface of a second substrate facing a first substrate(100). An organic emitting layer(204) is provided on a lower portion of the first electrode. A second electrode(206) is independently provided on a lower portion of the organic emitting layer at every pixel area and contacted to the connection electrode.

&copy KIPO 2005

Legal Status

Date of final disposal of an application (00000000)

Date of registration (00000000)

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

BEST AVAILABLE COPY

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁷
II05B 33/22

(11) 공개번호 10-2004-0079476
(43) 공개일자 2004년09월16일

(21) 출원번호 10-2003-00114283
(22) 출원일자 2003년03월07일

(71) 출원인 엘지.필립스 엘시디 주식회사
 서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자 박제용
 경기도 안양시 동안구 평촌동 933-7 삼마을 커링아파트 305동 701호

(74) 대리인 정원기

심사청구 : 있음

(54) 유기전제 발광소자와 그 제조방법

요약

본 발명은 유기전제 발광소자에 관한 것으로 특히, 박막트랜지스터 어레이부와 유기전제 발광부가 별도의 기판에 구성된 상부 반광식 듀얼플레이트 구조로 제작된 유기전제 반광소자(Dual Plate OLED : DPOLED)에 관한 것이다.

전술한 듀얼플레이트 구조에서는, 상기 박막트랜지스터 어레이부에 구성된 구동소자로부터 출력된 신호를 상기 유기전제 발광부로 입력하기 위해 상기 구동소자의 드레인 전극과 연결되는 연결전극을 구성하여 이때, 연결전극의 높이를 확보하기 위한 별도의 캡 유지수단을 구성한다.

이때, 상기 연결전극은 상기 구동소자의 드레인 전극과 다수개의 접촉부를 가지도록 구성한다.

내.도.도

도 4

냉.에.시

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기전제 발광소자의 구성을 개략적으로 도시한 단면도이고,

도 2는 박막트랜지스터 어레이부의 한 파장을 개략적으로 도시한 성면도이고,

도 3은 도 2의 Ⅲ-Ⅲ'을 따라 절단한 단면도이고,

도 4는 본 발명에 따른 유기전제 발광소자의 구성을 개략적으로 도시한 단면도이고,

도 5는 본 발명에 따른 유기전제 발광소자의 한 화소에 대응하는 박막트랜지스터 어레이부의 구성을 개략적으로 도시한 단면도이고,

도 6은 도 5의 $V-V'$ 를 따라 절단한 단면도이고,

도 7a 대지도 7b는 도 5의 V-V'를 따라 절단하여, 본 발명의 공정순서에 따라 동시화 공정 단계도이고

도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기전계 발광소자의 구성을 도시한 단면도이다.

〈도면의 주요부분에 대한 간단한 설명〉

100 : 제 1 기관 128 : 브레인 전극

140 : 갑 유치수단 142 : 연경 친구

200 : 제 2 기관 202 : 제 1 전구

204 : 유기 발광 206 : 제 2 장

250 : 셀리트 패션

별명의 상세한 설명

발명의 목적

별명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

은 $Recess$ 3.77% 중 8.6%는 물, 8.6%는 바위, 8.6%는 흙이다. 전자(electron)와 정자(hole)가 결합한 결시론(excitation)이 예상상태로부터 기상상태로 별이 될 때 발생하는 소자이다.

또한, 유기전체 밀강소자는 고정위 폐널부성(저전력, 고휘도, 고반응속도, 저중량)을 나타낸다. 이러한 부성 때문에 O

사용될 수 있는 강력한 차세대 디스플레이로 여겨지고 있다.

또한 제조 공정이 단순하기 때문에 생산원가율 기준의 LCD보다 많이 줄일 수 있는 장점이 있다.

상기 솔루션 테스트 케이스에 유통실험을 할수 있는 그 구성의 내용을 아래 기준대로 표로 나누어 놓았습니다. 그 내용에 따라 테스트를 진행해보시기 바랍니다.

여기 대안국회에 아파운이 있었으나, 대안국회 추가 투표하면 한 주당 개구원이 저하되는 단점이 있다.

만약 공동 네트워크 형 유기전개 막황소자는 높은 박황효율과 고 하질을 제공할 수 있는 장점이 있다.

이하. 노 1을 참조하여 종래의 6. 풍 뉴트리트스orgh 유기전체 발광소자의 구성

도 1은 궁내부의 유기신체 밀집조사와 구경률 계획적으로 도시화 토언이다.

이때, 상기 발광층(18)은 적(R), 녹(G), 청(B)의 컬러를 표현하게 되는데, 일반적인 방법으로는 상기 각 화소(P)마다 적, 녹, 청색을 발광하는 별도의 유기물질을 패턴하여 사용한다.

상기 제 1 기판(12)이 흡습제(22)가 부착된 제 2 기판(28)과 신련트(26)를 통해 합착되므로서 캠슬화된 유기전계 발광소자(10)가 완성된다.

이때, 상기 흡습제(22)는 캠슬내부에 침투할 수 있는 수분과 산소를 제거하기 위한 것이며, 기판(28)의 일부를 식각하고 식각된 부분에 흡습제(22)를 재우고 테이프(25)로 고정한다.

이하, 노 2를 참조하여 유기전계 발광소자의 박막트랜지스터 어레이부를 개략적으로 설명한다.

도 2는 유기전계 발광소자에 포함되는 박막트랜지스터 어레이부의 한 화소를 개략적으로 도시한 평면도이다.

일반적으로, 농동 매드릭스형 유기전계 발광소자의 박막트랜지스터 어레이부는 기판(12)에 정의된 다수의 화소(P)마다 스위칭 소자(T_S)와 구동 소자(T_D)와 스트리리지 캐퍼시터(storage capacitor : C_{ST})가 구성되며, 농작의 특성에 따라 상기 스위칭 소자(T_S) 또는 구동 소자(T_D)는 각각 하나 이상의 박막트랜지스터의 조합으로 구성될 수 있다.

이때, 상기 기판(12)은 부드러운 결연 기판을 사용하며, 그 재질로는 유리나 플라스틱을 예로 듣 수 있다.

도시한 바와 같이, 기판(12)상에 서로 소정 간격 이격하여 일 방향으로 구성된 게이트 배선(32)과, 상기 게이트 배선(32)과 결연막을 사이에 두고 서로 교차하는 데이너 배선(34)이 구성된다.

동시에, 상기 데이터 배선(31)과 평행하게 이격된 위치에 일 방향으로 전워 배선(35)이 구성된다.

상기 스위칭 소자(T_S)의 구동 소자(T_D)로 각각 게이트 전극(36,38)과 액티브층(40,42)과 소스 전극(46,48) 및 드레인 전극(50,52)을 포함하는 박막트랜지스터가 사용된다.

전술한 구성에서, 상기 스위칭 소자(T_S)의 게이트 전극(36)은 상기 게이트 배선(32)과 연결되고, 상기 소스 전극(46)은 상기 데이너 배선(34)과 연결된다.

상기 스위칭 소자(T_S)의 드레인 전극(50)은 상기 구동 소자(T_D)의 게이트 전극(38)과 전극(54)과 콘택홀(56)을 통해 연결된다.

또한, 상기 구동 소자(T_D)의 드레인 전극(52)은 화소부(I)에 구성된 제 1 전극(16)과 접촉하도록 구성된다.

이때, 상기 전원 배선(35)과 그 하부의 다결정 실리콘패턴(15)은 결연막을 사이에 두고 겹쳐져 스토리지 캐퍼시터(C_{ST})를 형성한다.

이하, 노 3을 참조하여 전술한 바와 같이 구성된 박막트랜지스터 어레이부를 포함하는 유기전계 반광소자의 단면구성을 설명한다.

도 3은 노 2의 Ⅲ-Ⅲ'을 따라 결단한 유기전계 발광소자의 단면도이다.(구동소자(T_D)와 발광부의 단면만을 도시한 도면이다.)

도시한 바와 같이, 유기전계 발광소자는 게이트 전극(38)과, 액티브층(42)과 소스 전극(56)과 드레인 전극(52)을 포함하는 구동소자인 박막트랜지스터(T_D)가 구성되고, 구동소자(T_D)의 상부에는 결연막(57)을 사이에 두고 구동소자(T_D)의 드레인 전극(52)과 접촉하는 제 1 전극(16)과, 제 1 전극(16)의 상부에 특정한 색의 빛을 발광하는 발광층(18)과, 반광층(18)과 상부에는 제 2 전극(20)이 구성된다.

상기 구동소자(T_D)와는 별도로 스트리리지 캐퍼시터(C_{ST})가 구성되어, 소스 전극(56)은 스트리리지 캐퍼시터(C_{ST})의 제 2 전극(전원배선)(35)과 접촉하여 구성된다. 상기 캐퍼시터 제 2 전극(36)의 하부에는 상기 다결정 실리콘인 게이터 캐퍼시터 제 1 전극(15)이 구성된다.

상기 구동소자(T_D)와 스트리리지 캐퍼시터(C_{ST})와 유기 반광층(18)이 구성된 기판의 전면에는 제 2 전극(20)이 구성된다.

전술한 구동 소자와 스토리지 캐시터가 구성된 각 화소는 각각(비도시)을 통해 분리되어 있다.

상기 제 1 전극(16)과 발광층(18)과 제 2 전극(20)으로 구성된 발광부에 시, 제 1 전극 및 제 2 전극이 두단서에 따라 하부 발광식(bottom emission)과 상부 발광식(top emission)으로 구별된다.

하부 발광식은 유기 발광소자를 재구화시 안정되고, 공정의 자유도가 높은 반면 개구율의 제한이 있어 고체상도의 제품에 적용하기 힘든 문제점이 있었다.

상부 발광식은 박막트랜지스터 디자인에 있어 자유도가 높고, 개구율 향상이 가능하기 때문에 수명이 긴 장점이 있지만, 두께 또는 만투닝 음극 전극에 의해 두께가 제한되어 양효율이 저하되는 한편 광무사도의 손실을 최소화하기 위해 박막형 보호막을 구성하기 때문에 충분히 외기로 차단하지 못하는 문제점이 있다.

별명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 전술한 바와 같은 문제를 해결하기 위한 목적으로 제안된 것으로, 박막트랜지스터 어레이부와 발광부가 별도의 기판에 각각 구성된 듀얼 플레이트 타입의 유기발광소자를 제안한다.

본 발명은 상기 박막트랜지스터 어레이부의 구동소자에서 출력된 신호를 상기 발광부에 입력하기 위한 별도의 연결전극을 상기 구동소자와 드레인 전극과 연결하여 구성한다.

이때, 상기 연결전극의 높이를 유지하는 동시에 두 기판 사이의 갭을 유지하기 위해 별도의 갭 유지수단을 구성함에 있어서, 상기 연결전극은 상기 드레인 전극과 다수의 접촉부를 가지는 것을 특징으로 한다.

이와 같은 구성은, 두 기판을 합쳐하는 공정 중 가해지는 압력에 의해 상기 연결전극이 들뜨거나 부분적으로 단선되는 경향이 발생하더라도, 상기 연결전극은 디수의 접촉부를 가지므로 접촉경향이 발생하지 않는 장점이 있다.

발명의 구성 및 작용

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 특징에 따른 유기전계 발광소자는 서로 이격하여 구성되고, 다수의 화소영역(sub pixel)이 정의된 제 1 기판과 제 2 기판과; 상기 제 1 기판 일면의 각 화소 영역마다 구성되고, 게이트 전극과 액티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자의 구동소자에 있어서, 상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부를 가진 구동소자와; 상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제 1 콘택홀과, 상기 드레인 전극의 연장부를 노출하는 제 2 콘택홀을 포함하는 보호막과; 상기 노출된 연장부에 구성된 갭 유지수단과; 상기 구동소자의 노출된 드레인 전극과 연장부에 구성된 갭 유지수단을 따라 형성되는 동시에, 상기 갭 유지수단의 주변으로 노출된 연장부와 접촉하는 연결전극과; 상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 일면에 구성된 부드러운 제 1 전극과; 상기 제 1 전극의 하부에 구성된 유기 발광층과; 상기 유기 발광층의 하부에 상기 화소영역마다 독립적으로 구성되고, 상기 연결전극과 접촉하는 제 2 전극을 포함한다.

상기 갭 유지수단은 상기 제 1 기판과 제 2 기판의 이격거리를 유지하는 수단인 동시에, 상기 연결전극과 상기 제 2 전극과의 접촉을 양호하게 하기 수단이다.

상기 제 1 전극은 양극전극이고, 상기 제 2 전극은 음극 전극이다.

본 발명의 다른 특징에 따른 유기전계 발광소자는 서로 이격하여 구성되고, 다수의 화소영역(sub pixel)이 정의된 제 1 기판과 제 2 기판과; 상기 제 1 기판 일면의 각 화소 영역마다 구성되고, 게이트 전극과 액티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자와 구동소자에 있어서, 상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부를 가진 구동소자와; 상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제 1 콘택홀과, 상기 드레인 전극의 연장부를 노출하는 다수개의 콘택홀로 구성된 제 2 콘택홀을 포함하는 보호막과; 상기 구동소자의 드레인 전극의 연장부에 대응되지 않는 보호막 상에 구성된 갭 유지수단과; 상기 노출된 드레인 전극 및 연장부와 접촉하는 동시에 상기 갭 유지수단을 따라 형성된 연결전극과; 상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 일면에 구성된 부드러운 제 1 전극과; 상기 제 1 전극의 하부에 구성된 유기 발광층과; 상기 유기 발광층의 하부에 상기 화소영역마다 독립적으로 구성되고, 상기 연결전극과 접촉하는 제 2 전극을 포함한다.

본 발명의 제 1 특징에 따른 유기전계 발광소자 제조방법은 서로 이격하여 구성된 제 1 기판과 제 2 기판에 다수의 화소영역을 정의하는 단계와; 상기 제 1 기판 일면의 각 화소 영역마다 게이트 전극과 액티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자와 구동소자를 형성하는 단계에 있어서, 상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부

을 가진 구동소자 형성단계와; 상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제 1 콘택틀과, 상기 드레인 전극의 연장부를 노출하는 제 2 콘택틀을 포함하는 보호막을 형성하는 단계와; 상기 노출된 연장부 상에 구성된 케이지수단을 형성하는 단계와; 상기 구동소자의 노출된 드레인 전극과 연결되면서 상기 케이지수단을 따라 형성되는 동시에, 상기 케이지수단의 주변으로 노출된 연장부와 접촉하는 연결전극을 형성하는 단계와; 상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 일면에 부여한 제 1 전극을 형성하는 단계와; 상기 제 1 전극의 하부에 유기 반광층을 형성하는 단계와; 상기 유기 반광층의 하부에 상기 화소영역마다 독립적으로 구성되고, 상기 연결 전극과 접촉하는 제 2 전극을 형성하는 단계를 포함한다.

상기 제 1 전극은 양극전극이고 상기 제 2 전극은 음극 전극이다.

이때, 제 1 전극은 인듐-빈-옥사이드(ITO)와 인듐-정크-옥사이드(ITZO)와 인듐-빈-정크-옥사이드(ITZO)를 포함하는 부여 도전성 화합물 그룹 중 선택된 하나로 형성하고, 상기 제 2 전극은 칼슘(Ca), 알루미늄(Al), 마그네슘(Mg), 리튬(Li)을 포함하는 규수 중 선택된 하나 이상의 규수형성한다.

본 발명의 제 2 특징에 따른 유기전체 발광소자 제조방법은 서로 이격하여 구성된 제 1 기판과 제 2 기판에 나수의 화소영역(sub pixel)을 정의하는 단계와; 상기 제 1 기판 일면의 각 화소 영역마다, 케이드 전극과 액티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자와 구동소자를 형성하는 단계에 있어서, 상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부를 가진 구동소자 형성단계와; 상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제 1 콘택틀과, 상기 드레인 전극의 연장부를 렌델하게 노출하는 나수개의 콘택틀로 구성된 제 2 콘택틀을 포함하는 보호막을 형성하는 단계와; 상기 구동소자의 드레인 전극 연장부에 내용되지 않는 보호막 상에 케이지수단을 형성하는 단계와; 상기 노출된 드레인 전극 및 연장부와 접촉하는 동시에 상기 케이지수단을 따라 구성된 연결전극을 형성하는 단계와; 상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 일면에 부여한 제 1 전극을 형성하는 단계와; 상기 제 1 전극의 하부에 유기 반광층을 형성하는 단계와; 상기 유기 반광층의 하부에 상기 화소영역마다 독립적으로 구성되고, 상기 연결전극과 접촉하는 제 2 전극을 형성하는 단계를 포함한다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 설명한다.

-- 제 1 실시예 --

본 발명은 악박드엔시스터 어레이부와 발광부를 맨드의 기판에 구성하고, 발광부에 신호를 인가하는 번설전극은 악박트렌지스터 어레이부에 형성함에 있어, 연결전극의 하부에는 케이지수단을 구성하고 케이지수단을 따라 형성된 연결전극은 어레이부와 나수의 접촉부를 통해 접촉되도록 구성된 것을 특징으로 한다.

도 4는 본 발명에 따른 뉴연 플레이트 타입 유기전체 반광소자와 구성을 개략적으로 노시한 단면도이다.

노시한 바와 같이, 본 발명에 따른 유기전체 반광소자(99)는 부여한 제 1 기판(100)과 제 2 기판(200)을 실번드(sealant)(250)를 통해 암착하여 구성한다.

상기 제 1 및 제 2 기판(100,200)을 나수의 화소(P)로 정의하고, 상기 제 1 기판(100)에는 화소(P)마다 앞서 설명한 노 2의 구성과 같이, 박막트렌지스터(스위칭 소자와 구동소자)(T)와 어레이 배선(미도시)을 구성한다.

제 1 기판(100)과 마주보는 제 2 기판(200)의 일 면에는 공통전극인 부여한 제 1 전극(202)을 구성한다.

상기 제 1 전극(202)의 하부에는 발광층(210)을 구성하고, 발광층(204)의 하부에는 각 화소(P)마다 독립적으로 제 2 전극(206)을 구성한다.

전술한 구성에서, 상기 발광층(210)은 상기 제 1 전극의 하부에 풀 수송층(HTI)을 구성하고, 풀 수송층(204a)의 하부에 각 화소(P)마다 특유의 빛을 발광하는 주 발광층(204b)을 구성하고, 상기 주 발광층(204b)과 상기 제 2 전극(206)사이에 전자 수송층(ETL)(204c)을 구성한다.

전술한 구성에서, 상기 구동소자(T)의 드레인 전극(128)에서 화소로 연장부(F)를 형성한 후, 연장부(F)의 상부에 기등 형상의 유기막 케이드인 케이지수단(140)을 형성한다.

이때, 상기 케이지수단(140)의 주변으로 하부의 드레인 전극(128)이 노출된 형상이다.

다음으로, 상기 드레인 전극(128) 및 연장부(F)에 접촉하는 동시에 상기 케이지수단(140)을 따라 증착된 연결전극(142)을 형성한다.

상기 연결전극(142)은 상기 접유지수단(140)에 의해 순차계 상기 연결전극(142)과 접촉할 수 있으나, 접유지수단(140)의 주변으로 노출된 드레인 전극(128)에 모두 접촉되는 형상이다. 이러한 형상을 가진 박막트랜지스터 어레이기관의 구성을 이하, 도 5에서 설명한다.

도 5는 도 4의 듀얼플레이트 타입의 유기전계 반광소자용 박막트랜지스터 어레이기관의 한 화소를 확대한 평면도이다.

(이때, 스위칭 소자와 구동 소자로 미정질 박막트랜지스터를 사용한다.)

도시한 바와 같이, 일 방향으로 게이트 배선(도시하지는 않았지만 서로 평행하게 이겨낸 다수의 게이트 배선)(106)을 형성하고, 게이트 배선(106)과 수직하게 교차하는 데이터 배선(124)과 이와는 평행하게 이겨낸 전원배선(132)을 구성한다.

전술한 구성에서, 상기 게이트 배선(106)과 이와는 수직한 데이터 배선(124) 및 전원배선(132)에 의해 정의된 영역을 화소(자세히는 sub pixel)이라 한다.

상기 게이트 배선(106)과 데이터 배선(124)의 교차점에는 스위칭 소자(T_S)와 구동 소자(T_D)를 구성한다.

스위칭 소자(T_S)와 구동 소자(T_D)는 각각 게이트 전극(102,104)과 액티브층(112,116)과 소스 전극(126)과 드레인 전극(128)으로 구성된다.

상기 스위칭 소자(T_S)의 게이트 전극(102)은 게이트 배선(106)과 연결하고, 소스 전극(126)은 데이터 배선(124)과 연결하고, 드레인 전극(128)은 상기 구동소자(T_D)의 게이트 전극(104)과 연결하여 구성을 한다.

상기 구동소자(T_D)의 소스 전극(126)은 상기 전원배선(132)과 연결하여 구성하고, 드레인 전극(128)은 화소로 연결되는 연장부(F)를 가진다.

이러한 구성에서, 어레이기관을 보호하는 보호마을 시작하여, 상기 드레인 전극(128)과 연장부(F)를 각각 노출하도록 제 1 콘택홀(136)과 제 2 콘택홀(138)을 구성한다.

전술한 구성에서, 상기 제 2 콘택홀(138)을 통해 노출된 연장부(F)의 상부에는 기둥형상의 유기막 폐년인 접유지수단(140)을 구성하며, 접유지수단(140)의 표면을 따라 형성되고 상기 제 1 콘택홀(136)을 통해 드레인 전극(128)과 접촉하는 동시에, 이의 연장부(F)에 동시에 접촉하는 연결전극(142)을 구성한다.

전술한 바와 같은 구성은, 상기 접유지수단(140)에 의해 도 4에 구성한 유기발광부의 제 2 전극과 접촉하기 위해 노출되었고, 접촉부위를 방지할 수 있고, 연결전극(142)과 드레인 전극(128)의 접촉면적을 넓게 확보할 수 있으므로 상기 연결전극(142)이 부분적으로 오른되더라도 신호는 계속 출력될 수 있으므로 신호불량을 방지할 수 있는 장점을 가진다.

이하, 도 6을 통해 상기 구동소자 및 스위칭 소자의 단면 구성을 설명한다.

도시한 바와 같이, 기판(100)상에 정의된 스위칭부(S)와 구동부(D)에 각각 게이트 전극(102,104)을 형성한다.

상기 각 게이트 전극(102,104)의 상부에는 게이트 셀프박(108)이 위치하고, 이브 셀프박(108)상에는 액티브층(112,116)과 오직 콘택층(114,118)을 구성한다.

상기 셀프박(108)은 상기 구동부(D)에 위치한 게이트 전극(104)의 일부를 노출하도록 구성한다.

상기 스위칭부(S)와 구동부(D)의 상부에 구성된 오직 콘택층(114,118)의 상부에 각각 이겨낸 소스 전극(120,126)과 드레인 전극(122,128)을 구성하게 되는데 이때, 상기 스위칭부(S)의 드레인 전극(122)은 상기 구동부(D)의 노출된 게이트 전극(104)과 접촉하도록 구성한다.

상기 구동부(D)의 드레인 전극(128)은 화소로 소정면적 연장부(F)를 가진다.

이로써, 스위칭부(S)에 스위칭 소자를 구성하고, 구동부(D)에 구동소자를 구성할 수 있다.

상기 소스 및 드레인 전극(120,126)(122,128)이 형성된 기판(100)의 전면에는 M.호박(132,134)을 구성하되, M.호박은 상기 구동부(D)의 드레인 전극(128)과, 이에 연장된 연장부(F)를 각각 노출한다.

상기 노출된 연장부(F)의 상부에는 소정의 각으로 강사진 기둥형상의 유기막 폐단인 캡유지수단(140)을 구성한다.

상기 캡유지수단(140)이 상부에는 상기 노출된 드레인 전극(128)과 캡유지수단(120)의 주변으로 노출된 드레인 전극(128)의 연장부(F)와 접촉하면서 상기 캡유지수단(140)을 따라 형성되도록 연전전극(142)을 구성한다.

전술한 바와 같은 단면 구성을 가진 본 발명에 따른 유기전계 발광소자와 제조공정을 이하, 도면을 참조하여 실명한다.

이하, 도 7a 내지 도 7f는 본 발명에 따른 뉴얼플레이트 타입 유기전계 발광소자용 박막트랜지스터 어레이기판의 제조공정을 공정순서에 따라 노출한 공정 단면도이다.

도 7a에 도시한 바와 같이, 기판(100)상에 화소(P)를 정의하고, 화소(P)의 안쪽으로 스위칭부(S)와 구동부(D)를 정의한다.

상기 기판의 전면에 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(예를들면 AlNd)을 포함하는 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 폐단하여, 상기 스위칭부(S)와 구동부(D)에 각각 게이트 전극(102, 104)을 형성한다.

노출하시는 않았지만, 화소의 일측에 일방향으로 연장되고 상기 스위칭부(S)에 구성된 게이트 전극(102)과 연결된 게이트 배선(도 5의 106)을 형성한다.

다음으로, 상기 스위칭부(S)와 구동부(D)에 각각 게이트 전극(102, 104)이 형성된 기판(100)의 전면에 질화 실리콘(SiN_x)과 산화 실리콘(SiO₂)을 포함하는 무기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여 게이트 절연막(106)을 형성한다.

도 7b에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 절연막(106)상에 비정질 실리콘(a-Si:H)과 불순물 비정질 실리콘(n+a-Si:H)을 연속하여 증착하고 폐단하여, 상기 스위칭부(S)와 구동부(D)에 각각 적층된 형상의 액티브층(112, 116)과 오비 쿠비층(114, 118)을 형성한다.

다음으로, 상기 게이트 절연막(106)을 삭제하는 공정을 진행하여 상기 스위칭부(S)에 근접하여 구성된 구동부(D)의 게이트 전극(104)을 일부 노출하는 제 1 콘택처(110)을 형성한다.

도 7c에 도시한 바와 같이, 상기 액티브층(112, 116)과 오비 쿠비층(114, 118)이 형성된 기판(100)의 전면에 크롬(Cr), 폴리리튬(Mo), 디스캔(W), 구리(Cu), 티타늄(Ti) 등을 포함하는 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 폐단하여, 상기 스위칭부(S)와 구동부(D)에 위치하는 오비 쿠비층(114, 118)의 상부에 서로 이격된 소스 전극(120, 126)과 드레인 전극(122, 128)을 각각 형성한다.

이때, 상기 스위칭부(S)의 드레인 전극(122)은 상기 구동부(D)의 게이트 전극(104)과 접촉하도록 형성한다.

도시하시는 않았지만, 상기 게이트, 배선(도 5의 106)과 수직한 방향으로 일방향으로 구성되고 상기 스위칭부(S)의 소스 전극(120)과 연결된 데이터 배선(도 5의 121)을 형성한다.

도 7d에 도시한 바와 같이, 상기 소스 및 드레인 전극(120, 126)(122, 128)이 형성된 기판(100)의 전면에 질화 실리콘(SiN_x)과 산화 실리콘(SiO₂)을 포함하는 무기절연물질 그룹 중 선택된 하나 또는 경우에 따라서는 엔조사이글로부텐(FCR)과 아크릴(acryl)계 수지(resin)를 포함하는 유기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착 또는 도포하여 제 1 보호막(130)을 형성한다.

다음으로, 상기 구동부(D)의 소스 전극(126)의 일부를 노출하는 공정을 진행한다.

다음으로, 상기 제 1 보호막(130)이 형성된 기판(100)의 전면에 앞서 설명한 노전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 폐단하여, 상기 노출된 소스 전극(126)과 접촉하면서 상기 게이트 배선(도 5의 106)과는 수직한 방향으로 연장된 전원 배선(132)을 형성한다.

도 7e에 도시한 바와 같이, 상기 전원 배선(132)이 형성된 기판(100)의 전면에 앞서 설명한 질연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착 또는 도포하여 제 2 보호막(131)을 형성한다.

다음으로, 상기 제 1 보호막 및 제 2 보호막(132, 134)을 폐단하여, 상기 구동부(D)에 위치하는 드레인 전극(128)의 일부와 드레인 전극(128)에서 연장된 연장부(F)를 거의 노출하는 제 2 콘택처(136)과 제 3 콘택처(138)을 형성한다.

도 7f에 도시한 바와 같이, 상기 드레인 전극(128)과 이에 연장된 연장부(F)를 노출하는 제 2 보호막(131)이 형성된 기판(100)의 전면에 엔조사이클로부텐(BCB)과 아크릴(acryl)계 수지(resin)를 포함하는 유기질연물질 그룹 중 선택된 하나를 두텁게 도포한 한 후 패턴하여, 상기 노출된 드레인 전극(128)의 연장부(F)상에 기동형상의 캡유지수단(140)을 형성한다.

다음으로, 상기 캡유지수단(140)이 형성된 기판(100)의 전면에 전술한 바와 같은 도전성 금속을 증착하고 패턴하여, 상기 노출된 드레인 전극(128)과 이에 연장된 연장부(F)와 접촉하면서 상기 캡유지수단(140)을 따라 구성된 연결전극(142)을 형성한다.

전술한 공정을 통해 본 발명에 따른 유기전계 반광소자를 제작할 수 있다.

이하, 제 2 실시예를 통해 상기 제 1 실시예의 변형예를 설명한다.

-- 제 2 실시예 --

본 발명의 제 2 실시예는 상기 연결 전극과 드레인 전극의 접촉부를 다수개 구성하여 접촉면적을 늘리는 것을 특징으로 한다.

도 8은 본 발명에 따른 뉴얼플레이트 다워 유기전계 반광소자용 박막트랜지스터 어레이기판의 다른 구성을 개략적으로 도시한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 기판(300)상에 정의된 스위칭부(S)와 구동부(D)에 각각 게이트 전극(302,304)을 형성한다.

상기 각 게이트 전극(302,304)의 상부에는 게이트 질연막(308)이 위치하고, 이트 질연막(308)상에는 액티브층(312,316)과 오미 콘택층(314,318)을 구성한다.

상기 게이트 질연막(308)은 상기 구동부(D)에 위치한 게이트 전극(304)의 일부를 노출하도록 구성한다.

상기 스위칭부(S)와 구동부(D)의 상부에 구성된 오미 콘택층(314,318)의 상부에 각각 이격된 소스 전극(320,326)과 드레인 전극(322,328)을 구성하게 되는데 이때, 상기 스위칭부(S)의 드레인 전극(322)은 상기 구동부(D)의 노출된 게이트 전극(302)과 접촉하도록 구성한다.

상기 구동부(D)의 드레인 전극(328)은 최소로 소정면적 인장부(F)를 가진다.

이로써, 스위칭부(S)에 스위칭 소자를 구성하고, 구동부(D)에 구동소자를 구성할 수 있다.

상기 소스 및 드레인 전극(320,326)(322,328)이 형성된 기판(300)의 전면에는 보호막(332,334)을 구성하되, 보호막에 상기 구동부(D)의 드레인 전극(128)과, 이에 연장된 연장부(F)를 각각 노출하는 나수의 콘택풀(136,138)을 형성한다.

상기 노출된 연장부(F) 이외의 보호막(330,334) 상부에 경사진 기동형상의 유기막 패턴인 캡유지수단(340)을 구성한다.

상기 캡유지수단(340)의 상부에는 상기 노출된 드레인 전극(328) 및 다수의 콘택풀(138)에 의해 노출된 연장부(F)와 접촉하면서 상기 캡유지수단(340)을 따라 형성되도록 연결전극(342)을 구성한다. 이때, 상기 구동부(D)의 소스 전극(326)과 연결되는 전위 배선(332)을 더욱 구성한다.

전술한 바와 같은 제 1 및 제 2 실시예에 따른 유기전계 반광소자의 캡유지수단은 앞서 설명한 도 4의 구성에서 설명한 제 1 및 제 2 기판의 이격거리별 유지하는 역할을 하며 동시에, 상기 연결전극과 유기반광부의 제 2 전극과의 접촉 복구를 방지하기 위한 역할을 한다.

이러한 구성에서, 본 발명의 특징은 전술한 바와 같이 상기 드레인 전극과 연결전극 사이의 접촉면적을 넓히는 것이다.

이와 같은 구성은 제 1 및 제 2 기판을 합착하는 공정 중 상기 캡유지수단이 압력에 의해 눌려 연결전극에 부분적인 오픈이 발생하더라도 신호의 흐름에 영향을 주지 않도록 하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

본 발명에 따른 유기전계 발광소자는 아래와 같은 효과가 있다.

첫째, 본 발명에 따른 유기전계 발광소자는 바마트렌지스터 어레이부와 유기 발광부가 별도의 기판으로 구성됨으로 인하여 생상판리의 측면에서 보다 효율적이다.

둘째, 상부 밖광팅이므로 하부 어레이패턴의 밍상에 영향을 받지 않아 고 해상도 및 개구율을 확보할 수 있는 효과가 있다.

셋째, 발광부를 바마트렌지스터 어레이패턴의 상부에 구성하지 않고 별도로 구성하기 때문에, 유기전계 발광층을 형성하는 풍진 중 삼기 바마트렌지스터에 미칠 수 있는 영향들을 고려하지 않아도 되므로 수율을 향상하는 효과가 있다.

넷째, 바마트렌지스터 어레이부에 소정 높이를 가지는 캡유지수단을 구성함으로써, 구동소자와 발광부의 제2전극에 동시에 접촉하는 연결전극의 접촉특성을 원활히 하는 효과가 있다.

다섯째, 삼기 구동소자의 드레인 전극과 삼기 연결전극을 다수의 접촉부를 통해 연결되도록 한으로서 접촉면적을 넓게 확보하여, 삼기 연결전극이 부분적으로 난선되더라도 신호의 흐름을 원활히 할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

서로 이격하여 구성되고 다수의 화소영역(sub pixel)이 정의된 제1기판과 제2기판과;

상기 제1기판 일면의 각 화소 영역마다 구성되고, 게이트 전극과 액티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자와 구동소자에 있어서,

상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부를 가진 구동소자와;

상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제1콘택홀과, 상기 드레인 전극의 연장부를 노출하는 제2콘택홀을 포함하는 보호막과;

상기 노출된 연장부 상에 구성된 캡유지수단과;

상기 구동소자의 노출된 드레인 전극과 연결되면서 상기 캡유지수단을 따라 형성되는 동시에, 상기 캡유지수단의 주변으로 노출된 연장부와 접촉하는 연결전극과;

상기 제1기판과 마주보는 제2기판 일면에 구성된 무명한 제2전극과;

상기 제1전극의 하부에 구성된 유기 발광층과;

상기 유기 발광층의 하부에 상기 화소영역마다 녹임적으로 구성되고, 상기 연결전극과 접촉하는 제2전극을 포함하는 유기전계 발광소자.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 캡유지수단은 상기 제1기판과 제2기판의 이격거리를 유지하는 수단인 유기전계 발광소자.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 제1전극은 양극전극이고 상기 제2전극은 음극 전극인 유기전계 광소자.

청구항 4.

제 3 항에 있어서.

상기 제 1 전극은 인듐-린-옥사이드(ITO)와 인듐-진크-옥사이드(IZO)와 인듐-린-진크-옥사이드(ITZO)를 포함하는 주성 도진성 화합물 그룹 중 선택된 하나인 유기전계 반광소자.

청구항 5.

제 3 항에 있어서.

상기 제 2 전극은 칼슘(Ca), 알루미늄(Al), 마그네슘(Mg), 리튬(Li)을 포함하는 금속 중 선택된 하나 이상의 금속으로 구성된 유기전계 반광소자.

청구항 6.

서로 이격하여 구성되고 나수의 화소영역(sub pixel)이 정의된 제 1 기판과 제 2 기판과;

상기 제 1 기판 일면의 각 화소 영역마다 구성되고, 게이트 전극과 엑티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자와 구동소자에 있어서.

상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부를 가진 구동소자와;

상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제 1 콘택홀과, 상기 드레인 전극의 연장부를 래핑하게 노출하는 다수개의 콘택홀로 구성된 제 2 콘택홀을 포함하는 보호막과;

상기 구동 소자의 드레인 전극 연장부에 대응되지 않는 보호막 상에 구성된 접 유지수단과;

상기 노출된 드레인 전극 및 연장부와 접촉하는 동시에 상기 접 유지수단을 따라 형성된 연결전극과;

상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 일면에 구성된 투명한 제 1 전극과;

상기 제 1 전극의 하부에 구성된 유기 반광층과;

상기 유기 반광층의 하부에 상기 화소영역마다 독립적으로 구성되고, 상기 연결전극과 접촉하는 제 2 전극을 포함하는 유기전계 반광소자.

청구항 7.

서로 이격하여 구성된 제 1 기판과 제 2 기판에 다수의 화소영역을 정의하는 단계와;

상기 제 1 기판 일면의 각 화소 영역마다 게이트 전극과 엑티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자와 구동소자를 형성하는 단계에 있어서.

상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부를 가진 구동소자 형성단계와;

상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제 1 콘택홀과, 상기 드레인 전극의 연장부를 노출하는 제 2 콘택홀을 포함하는 보호막을 형성하는 단계와;

상기 노출된 연장부 상에 구성된 접 유지수단을 형성하는 단계와;

상기 구동소자의 노출된 드레인 전극과 연결되면서 상기 접유수단을 따라 형성되는 동시에, 상기 접 유지수단의 주변으로 노출된 연장부와 접촉하는 연결전극을 형성하는 단계와;

상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 일면에 투명한 제 1 전극을 형성하는 단계와;

상기 제 1 전극의 하부에 유기 반광층을 형성하는 단계와;

상기 유기 반광층의 하부에 상기 화소영역마다 독립적으로 구성되고, 상기 연결전극과 접촉하는 제 2 전극을 형성하는 단계를

포함하는 유기전계 발광소자 제조방법.

청구항 8.

제 7 항에 있어서.

상기 전유지수단은 상기 제 1 기판과 제 2 기판의 이격거리를 유지하는 수단인 유기전계 발광소자 제조방법.

청구항 9.

제 7 항에 있어서.

상기 제 1 전극은 양극전극이고, 상기 제 2 전극은 음극 전극인 유기전계 광소자 제조방법.

청구항 10.

제 9 항에 있어서.

상기 제 1 전극은 인듐-린-옥사이드(IZO)와 인듐-징크-옥사이드(IZO)와 인듐-린-징크-옥사이드(IZZO)를 포함하는 투명 도전성 화합물 그룹 중 선택된 하나인 유기전계 발광소자 제조방법.

청구항 11.

제 9 항에 있어서.

상기 제 2 전극은 칼슘(Ca), 알루미늄(Al), 마그네슘(Mg), 리튬(Li)을 포함하는 금속 중 선택된 하나 이상의 금속으로 구성된 유기전계 발광소자 제조방법.

청구항 12.

시로 이격하여 구성된 제 1 기판과 제 2 기판에 다수의 화소영역(sub pixel)을 정의하는 단계와;

상기 제 1 기판 일면의 각 화소 영역마다, 케이트 전극과 엑티브층과 소스 전극과 드레인 전극으로 구성된 스위칭 소자와 구동소자를 형성하는 단계에 있어서.

상기 구동소자는 화소영역으로 연장된 연장부를 가진 구동소자 형성단계와;

상기 구동소자와 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 구동소자의 드레인 전극을 노출하는 제 1 콘택트과, 상기 드레인 전극의 연장부를 렌덤하게 노출하는 다수개의 콘택트로 구성된 제 2 콘택트를 포함하는 보호막을 형성하는 단계와;

상기 구동 소자의 드레인 전극 연장부에 대응되지 않는 보호막 상에 전유지수단을 형성하는 단계와;

상기 노출된 드레인 전극 및 연장부와 접촉하는 동시에 상기 전유지수단을 따라 구성된 연결전극을 형성하는 단계와;

상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 일면에 투명한 제 1 전극을 형성하는 단계와;

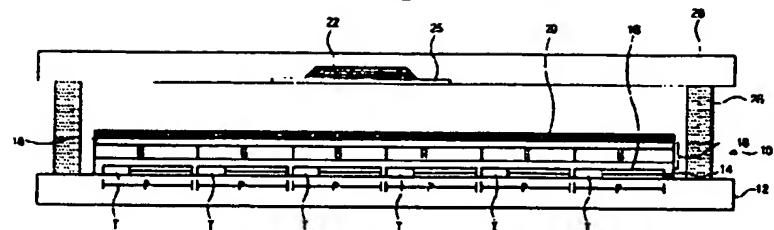
상기 제 1 전극의 하부에 유기 발광층을 형성하는 단계와;

상기 유기 발광층의 하부에 상기 화소영역마다 복합적으로 구성되고, 상기 연결전극과 접촉하는 제 2 전극을 형성하는 단계와;

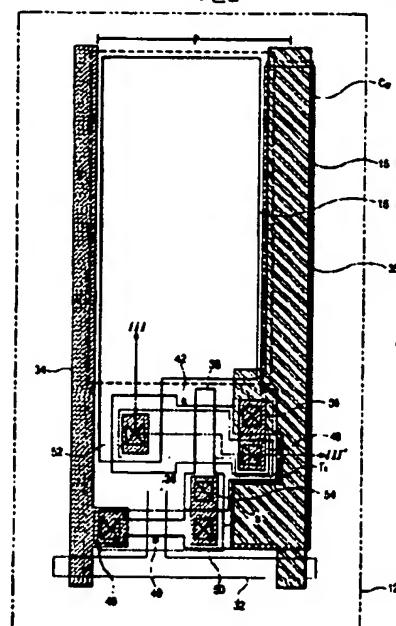
포함하는 유기전계 발광소자 제조방법.

도면

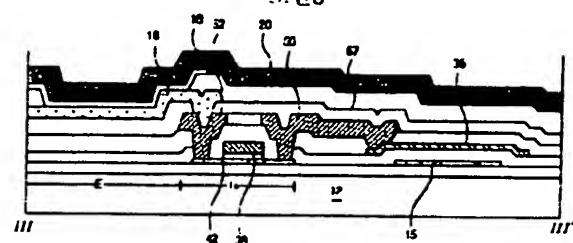
도면1



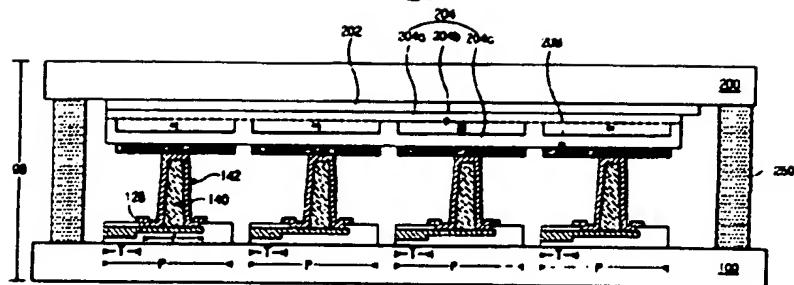
도면2



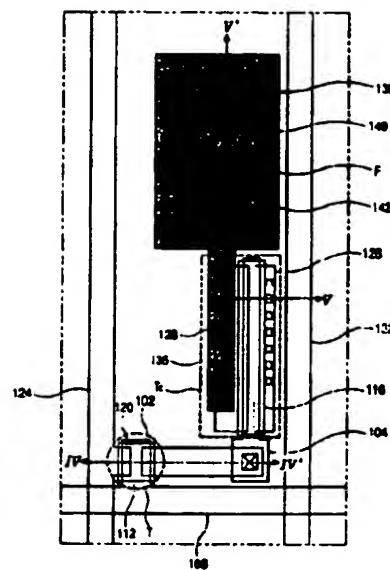
도면3



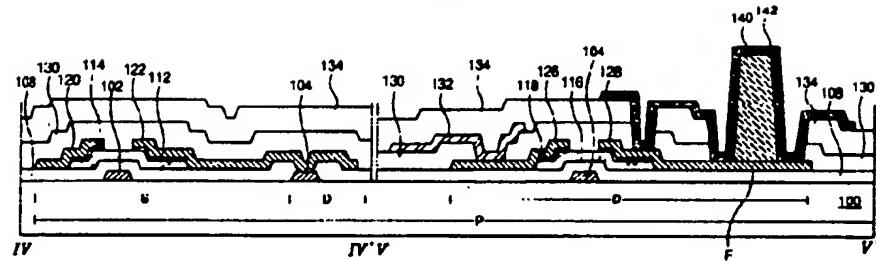
도면4



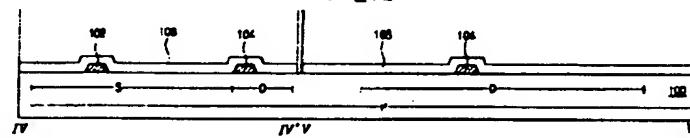
도면5



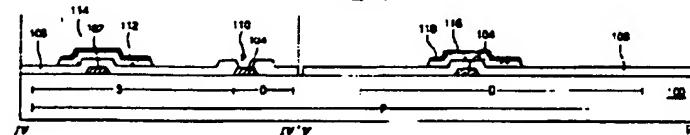
도면6



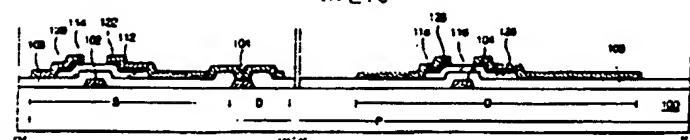
도면7a



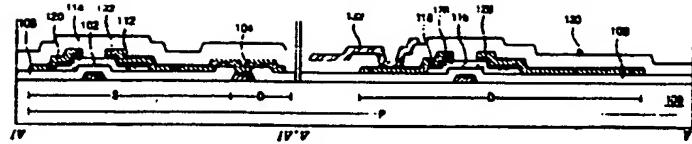
도면7b



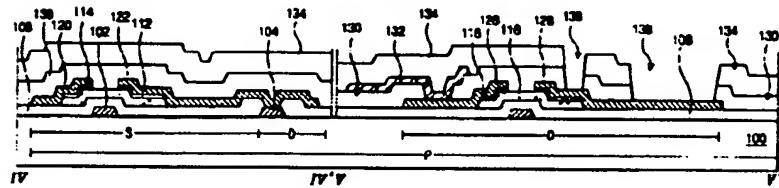
도면7c



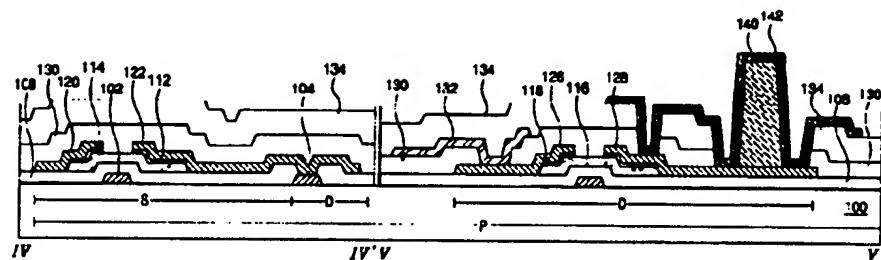
노년7d



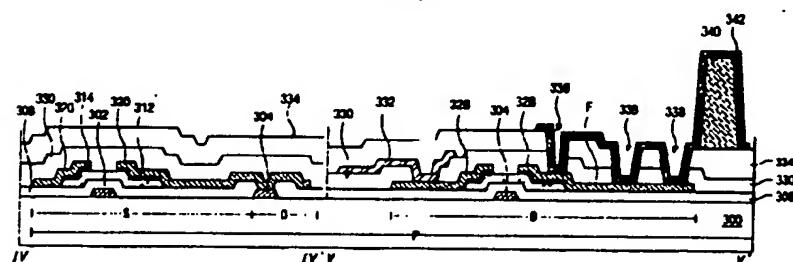
도면7



도전70



도록3



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.